时效氚化锆的氦释放及结构变化

梁建华,彭述明,周晓松,丁 伟,龙兴贵

(中国工程物理研究院 核物理与化学研究所,四川 绵阳 621900)

摘要:实验测量了氚化锆时效过程中的³He释放以及结构变化。实验结果表明,面心四方结构 ZrH_{1.801} 相的氚化锆在 $n({}^{3}\text{He}_{gen})/n(Zr)$ 小于 0.27 的时效期间,³He 的释放系数处于 $10^{-6} \sim 10^{-5}$ 量级,生成的 ³He几乎全部被氚化物捕获。受季节温差的影响,³He 的释放系数呈波浪式变化。随 $n({}^{3}\text{He}_{gen})/n(Zr)$ 的增加,氚化锆的晶胞体积经历了增大、维持恒定以及减小 3 种变化。

关键词: 氚化锆; 氦; X 射线衍射

中图分类号:TL99 文献标志码:A 文章编号:1000-6931(2010)08-0910-05

He Release and Structure Evolution of Aging Zirconium Tritide

LIANG Jian-hua, PENG Shu-ming, ZHOU Xiao-song, DING Wei, LONG Xing-gui (Institute of Nuclear Physics and Chemistry, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China)

Abstract: Helium release and structure evolution of Zr tritide with fct-ZrH_{1.801} phase were investigated. It proves that the ³He release fraction is between 10^{-6} and 10^{-5} while $n({}^{3}\text{He}_{\text{gen}})/n(\text{Zr})$ is smaller than 0.27. The ³He generated is trapped deeply in the tritide. The release fraction varies in wave with the temperature change between summer and winter. X-ray diffraction results show that the cell volume experiences increase, invariablenes and decrease with the $n({}^{3}\text{He}_{\text{gen}})/n(\text{Zr})$ increasing.

Key words: zirconium tritide; helium; X-ray diffraction

氚半衰期为 12.323 a,衰变产物为³He。 ³He为闭合的电子壳层结构,很难与其它物质 形成化合物。³He 在氚化物中的不断积累将使 氚化物产生破裂、粉化等物理损伤,影响氚化物 的使用性能。为此,氚化物中³He 的行为引起 诸多学者的关注。多种时效氚化物的 TEM 研 究^[1-7]均已证明,在氚化物时效的早期即已观察 到氦泡。氦泡的演化包括泡的形核、长大、聚 集、迁移、破裂等过程,是研究时效氚化物行为 的主要方向之一。

由于³He的不可溶性,生成的³He在时效 过程中会从氚化物中释放。研究^[8-9]表明,时效 初期,氚化物中生成的³He的释放系数(释放量 与生成量之比)低于1%,只有当生成的³He达 到一定浓度(因材料而异)时,释放的³He量才 与生成的量相当。

收稿日期:2009-12-09;修回日期:2010-04-20

基金项目:国家自然科学基金资助项目(50871106);中国工程物理研究院重大科学技术基金资助项目(2009A0301015) 作者简介:梁建华(1974—),男,山西稷山人,副研究员,硕士,从事贮氚材料研究

本工作采用 X 射线衍射(XRD)测量时效 过程中氚化锆结构的变化,采用四极质谱计测 量时效氚化锆³He的释放,结合已发表的 TEM 研究成果^[1-2],研究氚化锆时效过程中氦的 演化。

1 实验

1.1 样品制备

高纯锆被加热蒸发沉积到钼基底上,在氚 化系统上被氚化为面心四方(fct)结构的 ZrH_{1.801}单相氚化物。样品时效初期的 XRD 谱 及物相分析示于图 1。



图 1 氚化锆 XRD 谱 Fig. 1 XRD pattern of zirconium tritide

1.2 实验测量

使用 Philip X'Pro 型多功能 X 射线衍射 仪分析样品的物相与结构。X 射线源为 Cu K_a,管电压 45 kV,管电流 40 mA,物相分析为 连续扫描,步长 0.02 (°)/s。晶格常数分析为 步进扫描,步长 0.01°,每步时间 1 s。样品每次 测量装样以 Mo 的(110)面的峰重合(误差为 ±0.02°)为基准。

³He释放测量方法详见文献[9-10]。

2 结果与分析

2.1 时效氚化锆的氦释放

时效氚化锆的氦释放随氚化物中氦的生成 浓度的变化如图 2 所示。氦释放系数定义为每 个测量周期内释放的氦量与该周期内氦的生成 量的比值。从图 2 可看出,生成的氦与锆物质 量的比 n(³ He_{gen})/n(Zr)小于 0.27 时,³ He 的 释放系数处于 10⁻⁶~10⁻⁵量级,生成的³ He 几 乎全被氚化锆捕获。³ He 的释放呈波浪式变化, 这种变化由样品测量的环境温度引起,波峰数 据在夏天测量,波谷数据在冬天测量。总体 上,³ He 的释放系数呈增长趋势,第1峰到第 2 峰对应释放系数的增长率高于第2峰到第3峰 对应释放系数的增长率。波谷连线 a 线与 d 线 交点处 $n({}^{3}\text{He}_{gen})/n(\text{Zr})$ 为 0.08,波峰连线 b 线 与 c 线交点处 $n({}^{3}\text{He}_{gen})/n(\text{Zr})$ 为 0.12。第1 峰在 $n({}^{3}\text{He}_{gen})/n(\text{Zr})$
 0.1 区间内,释放系数 峰值是高 $n({}^{3}\text{He}_{gen})/n(\text{Zr})$
 位谷值的 1.3 倍;第
2 峰在 0.1
 $n({}^{3}\text{He}_{gen})/n(\text{Zr})$

 0.2 区间内,释
放系数峰值是高 $n({}^{3}\text{He}_{gen})/n(\text{Zr})$

 0.2 区间内 2
 倍;第 3 峰在 0.2 < $n({}^{3}\text{He}_{gen})/n(\text{Zr})$







间内,释放系数峰值是高 $n({}^{3}\text{He}_{gen})/n(\text{Zr})$ 位谷 值的2.8倍,表明随着 $n({}^{3}\text{He}_{gen})/n(\text{Zr})$ 的提 高,温度对 ${}^{3}\text{He}$ 释放的影响越来越显著,氚化锆 对 ${}^{3}\text{He}$ 的束缚力逐渐减弱。

2.2 时效氚化锆结构分析

时效氚化锆结构分析结果表明,随着氚浓 度的减少以及氦浓度增大,氚化锆的衍射谱无 新增和减少谱峰,说明时效过程中无新相生成。 时效过程中峰的变化主要有3种,即峰的移动, 峰强减小和峰宽增加。对谱峰拟合计算可得到 晶胞参数随氦浓度的变化(图3)。





由图 3 可知,生成的氦与锆物质量的比 $n({}^{3}\text{He}_{gen})/n(\text{Zr})达到约 0.1 前, 氚化锆的晶格$ 常数 a 呈线性增大,之后趋于平缓;至 $<math>n({}^{3}\text{He}_{gen})/n(\text{Zr})达到 0.22 后, 开始有减小的$ $趋势。<math>n({}^{3}\text{He}_{gen})/n(\text{Zr})达到约 0.05 前, c$ 轴呈 线性增大,(311)面与(222)面组合计算的 c 轴 值保持平稳,直至 $n({}^{3}\text{He}_{gen})/n(\text{Zr})达到约0.21后趋$ 于平稳。(111)面与(200)面组合计算的 c 轴在 $<math>n({}^{3}\text{He}_{gen})/n(\text{Zr})$ 大于 0.05 后开始减小, 至 $n({}^{3}\text{He}_{gen})/n(\text{Zr})=0.15后趋于平稳。$

由晶胞体积随 n(³He_{gen})/n(Zr)的变化(图 3)可知,n(³He_{gen})/n(Zr)小于 0.06 时,晶胞体 积线性增加,而后增加趋势变缓,至 n(³He_{gen})/ n(Zr)大于 0.1后趋于平稳;n(³He_{gen})/n(Zr) 大于 0.16后,开始明显减小。

时效过程中的峰展宽使相邻峰相连,比如

 $n(^{3} \text{He}_{gen})/n(\text{Zr})$ 达到 0.07 时,(311)面与 (222)面的峰已相连,(111)面与(200)面的峰相 连,造成半峰宽分析误差较大。但由于(111)面 峰强明显强于(200)面,因此,(111)面的半峰宽 变化受邻峰展宽影响较小。各晶面半峰宽的变 化趋势如图 4 所示。由图 4 可知,各晶面峰的 半峰宽变化趋势相同。时效过程中无明显的各 向异性变化。 $n(^{3} \text{He}_{gen})/n(\text{Zr})$ 达到 0.1之前, 随 $n(^{3} \text{He}_{gen})/n(\text{Zr})$ 的增大,半峰宽增宽,而后 保持平稳。



图 4 氚化锆各晶面半峰宽随氦浓度的变化 Fig. 4 FWHM of different lattice faces peaks of zirconium tritide changed with concentration of He generated

3 讨论

间隙位(四面体与八面体)填充原子、原有 的间隙原子被大体积原子取代以及晶胞格点位 置被大原子或原子团簇取代等点缺陷均可引起 晶格常数的增加。晶粒细化以及应力可引起衍 射峰展宽。对时效氚化物来说,衍射峰的宽化 还包括了形成无限尺寸缺陷和位错网的特征。

由于³He的生成, 氚化物中最初形成遍及 金属晶格的有迁移性的间隙缺陷。在时效最初 期, 大部分衰变产生的³He原子以这种迁移间 隙存在。随着³He浓度的增加, 间隙³He也快 速增加, 受相互间的应力场的影响, 间隙³He相 互聚集, 引起晶体局域发生塑性变形, 并使近邻 键发生断裂, 形成氦泡核和位错。在这种能量 条件下, 处于晶格中的基体原子有可能脱离原 来的位置, 挤入临近的晶格间隙形成所谓的自 间隙原子(SIA)-空位对(Frenkel pair)。³He原 子或团簇有可能被激发到留出的空位上而成为 补陷原子,形成³He_nV_m复合体。当沉积到已存 在的团簇与³He_nV_m复合体中的³He 与生成的 ³He量相当时,³He 的间隙浓度、气泡的成核速 率达到最大值。随着³He 浓度的增加,氦泡核 便以发射 SIA 的形式长大成小氦泡,同时伴随 着位错的生成,导致后续生成的³He 的深度捕 获。由于³He 不断向泡填入,使泡内的压强与 尺寸增加,晶体内切应力不断增加,使位错增 殖,形成位错环。TEM 研究证明,氚化锆老化 3 周(n(³He_{gen})/n(Zr)约为 0.006)便可观察到 尺寸为 1 nm 的氦泡以及位错环^[1]。

TEM 研究^[2]表明,随老化时间的增长,He 泡平均直径近似以 $t^{1/3}$ 速度增长,因此,氦泡平 均体积近似与时效时间呈线性增长关系。³ He 的生成浓度 c(t)与初始氚浓度 r_0 的关系为:

 $c(t) = r_0 [1 - \exp(-t \ln 2/T_{1/2})] \quad (1)$ 式中: t 为时效时间; T_{1/2} 为氚的半衰期。

当c(t) < 0.1时,c(t)与t可近似为线性关系。因此, $在 n(^{3}He_{gen})/n(Zr) < 0.1$ 区间内,氦 泡平均体积与 $n(^{3}He_{gen})/n(Zr)$ 也近似呈线性 关系。在图 3 中, $n(^{3}He_{gen})/n(Zr)$ 也近似呈线性 关系。在图 3 中, $n(^{3}He_{gen})/n(Zr) < 0.06$ 期间 晶胞体积随 $n(^{3}He_{gen})/n(Zr)$ 近似呈线性增长, 可推断,引起晶胞体积的增长的主要因素是氦 泡的长大,此阶段生成的³He 主要被相互孤立、 存在于位错环内的氦泡捕获。由于³He 不断向 泡聚集,使泡内气压不断增加(TEM 的动态衍 射结果表明了泡内的高气压特性^[2]),伴随新位 错环的生成以及已生成的位错环的扩张,引起 晶粒内位错密度及应力增加,XRD 谱峰因而表 现为半峰宽增加。

在 0.06<n(³Hegen</sup>)/n(Zr)<0.1 期间,随 着氚化物中氦浓度的增加,位错增殖,位错环由 于向外扩张而相连,逐渐形成网络,增加了晶体 内位错网的密度。当氦泡内压以及尺寸超过某 一临界值时,晶体的塑性变形限度满足不了氦 泡的尺寸长大要求,氦泡开始以冲出位错环的 形式长大,向位错网扩散迁移,氦泡的长大对晶 格常数的增大影响开始变弱。但新生成的孤立 氦泡速度还大于向位错网扩散迁移的氦泡速 度,晶胞体积与半峰宽仍表现为增加。

在 0.1<n(³He_{gen})/n(Zr)<0.16 期间,一 方面,新生成的氦泡以及孤立的氦泡的长大使 晶格尺寸长大;另一方面,由于衰变引起的氚浓 度的减小以及氦泡向位错网迁移引起晶格尺寸 的减小,此阶段晶胞体积基本恒定的状态表明, 晶格的长大效应与减小效应相互抵消。半峰宽 变化不大,表明位错网密度处于基本恒定的 状态。

在 0.16 $< n(^{3} \text{He}_{gap})/n(\text{Zr})$ 期间, 随着³ He 浓度的进一步增加,位错网中的氦泡体积与密 度不断增大,并开始向晶界处迁移,逐渐形成位 错网与晶界处的氦泡通道网,氦泡开始向通道 网塌陷,塌陷到通道网的³ He 的速度大干³ He 的牛成速度,加上因衰变使氚浓度减小,晶胞体 积开始 $n(^{3}\text{He}_{ran})/n(2r)$ 的增加而降低。半 峰宽变化不大,表明此阶段氦泡的变化未引起 位错网密度的明显变化。TEM 研究表明^[2],当 $n(^{3}\text{He}_{gen})/n(\text{Zr})$ 约为 0.2 时,相互连接的氦泡 通道网已形成(图5)。由氦泡组成的位错通道 网的任一分支与外界的连通均会导致³He 的突 然释放。压力驰豫期间,通道网在某一压力点 关闭,仅当系统中再次充满³He时再打开。3 s 时间分辨率的氦测量方法对氦铣原子比为 0.2 的氚化锆测量结果表明,连续的轻敲可导致氦 以爆发释放方式释放,瞬间的氦释放系数变化 近3个量级^[11]。在图2中,*n*(³He_{gen})/*n*(Zr)大 于 0.2 时,氦释放系数的波峰与波谷差明显增 大,说明氚化物对³He的束缚力减弱。但 10⁻⁵ 量级的氦释放系数表明,此时的氦仍被氚化物 牢牢捕获。



图 5 &-ZrT_{1.6}老化近 3 a 后的微观示意图^[2] Fig. 5 Scheme of microstructure elements curring in &-ZrT_{1.6} after aging for about 3 a^[2]

4 结论

面心四方结构 $ZrH_{1.801}$ 相的氚化锆在 $n({}^{3}He_{gen})/n(Zr) < 0.27时效期间,{}^{3}He 的释放$ $系数处于 <math>10^{-6} \sim 10^{-5}$ 量级,生成的{}^{3}He 几乎全 部被氚化物捕获;受季节温差影响,{}^{3}He 的释放 系数呈波浪式变化。随着 $n({}^{3}He_{gen})/n(Zr)$ 的 增大,氚化锆的晶胞体积经历了增大、维持恒定 以及减小 3 种变化。

感谢张晓红、刘锦华、王维笃、程贵钧、 汪清华等对样品制备给予的支持和帮助。

参考文献:

- [1] SCHOBER T, LASSER R. The aging of zirconium tritides: A transmission electron microscopy study[J]. Journal of Nuclear Materials, 1984, 120: 137-142.
- [2] SCHOBER T, TRINKAUS H, LASSER R. A TEM study of the aging of Zr tritides[J]. Journal of Nuclear Materials, 1986, 141-143: 453-457.
- [3] JAGER W, LASSER R, SCHOBER T, et al. Formation of helium bubbles and dislocation loops in tritium-charged vanadium[J]. Radiation Effection, 1983, 78: 165-176.
- [4] THOMAS G J, MINTZ J M. Helium bubbles in palladium tritide[J]. Journal of Nuclear Materials, 1983, 116: 336-338.
- [5] SCHOBER T, LASSER R, JAGER W, et al. An electron microscopy study of tritium decay in vanadium [J]. Journal of Nuclear Materials,

1984, 122& 123: 571-575.

- [6] SCHOBER T, TRINKAUS H. ³He bubble formation in titanium tritides at elevated temperatures: A TEM study[J]. Philosophical Magazine A, 1992, 65(5): 1 235-1 247.
- [7] FABRE A, DECAMPS B, FINOT E, et al. On the correlation between mechanical and TEM studies of the aging of palladium during tritium storage[J]. Journal of Nuclear Materials, 2005, 342: 101-107.
- [8] BEAVIS L C. Metal tritides helium emission, SAND79-0645[R]. Albuquerque, NM, USA: Sandia Labs., 1980.
- [9] 丁伟,龙兴贵,梁建华. Ti、Zr、Er 及 Nd 等金属氚 化物的³ He 释放[J]. 原子能科学技术,2008,42 (10):944-947.
 DING Wei, LONG Xinggui, LIANG Jianhua.
 ³ He release from Ti, Zr, Er and Nd tritides[J]. Atomic Energy Science and Technology, 2008, 42(10): 944-947(in Chinese).
- [10] 龙兴贵,翟国良,蒋昌勇,等. 用四极质谱计测定 从金属氚化物中释放的³He[J]. 原子能科学技 术,1996,30(1):55-61.

LONG Xinggui, ZHAI Guoliang, JIANG Changyong, et al. Measurement of ³He released from metal tritides by quadrupole mass spectrometer [J]. Atomic Energy Science and Technology, 1996, 30(1): 55-61(in Chinese).

[11] MITCHELL D J. Irregularlities in helium release rates from metal ditrides[J]. Journal of Applied Physics, 1985, 57(6): 1 855-1 860.